**Сафуат Булис Юсиф Ниер.**

**Оптические свойства и спектр локальных уровней твердых растворов TlGaS2-TlGaSe2 : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10. - Баку, 1982. - 153 с. : ил.**

**Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Сафуат Булис Юсиф Ниер**

**ВВЕДЕНИЕ**

**ГЛАВА I. МЕТОДИКА СИНТЕЗА И ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ**

**TlGoSJe^ ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.**

**§ I.I. Краткий литературный обзор физических свойств таллий-галяяевых сульфидов и седенидов**

**§ 1.2. Физико-химические свойства твердых раотворов**

**TIGqS2x&2«-X).V.**

**§ 1.3. Синтез и выращивание монокристаллов**

**Резюме.**

**ГЛАВА П. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КРАЯ ОСНОВНОЙ ПОЛОСЫ**

**ПОГЛОЩЕНИЯ МОНОШСТАЛЛОВ TlGoSJe^**

**ПРИ Х^ I**

**§ 2.1. Спектр и форма края основной полосы поглощения в полупроводниках**

**§ 2.2, Методика эксперимента**

**§ 2.3. Формирование края собственного поглощения монокристаллов и / lGoSe**

**§ 2.4. Край полосы поглощения TIGqS2x$€2(<-x) • • • 45 Резюме.**

**ГЛАВА III. СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ И ОПТИЧЕСКИЕ**

**КОНСТАНТЫ МОНОКРИСТАЛЛОВ TlGoSzySe^-x)**

**§ 3.1. О методике измерения диффузного отражения я обработке экспериментальных данных**

**§ 3.2. Межзонные переходы соединений**

**TlGoSe, л ТШаОг**

**§ 3.3. Спектр диффузного отражения твердых растворов**

**TlGaS2£e2(1.x) в интервале энергии 2\*6 эВ**

**§ 3.4. Диффузное отражение и механизм формирования края собственной полосы поглощения TIGqSzk^sO-x)\***

**§ 3.5. Дисперсия края полосы собственного поглощения в монокристаллах TlGoSz » TlGoSe**

**§ 3.6. Собственная интерференция и дисперсия у края собственной полосы поглощения TIGqS2 , TIGaSSe,**

**TlGaSe?**

**Резше.**

**ГЛАВА 1У. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЛОКАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В**

**ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ TlGoSzxSez(i.x)**

**§ 4.1. Температурная зависимость электропроводности монокристаллов TIGq$2xS~2(f-x) при постоянном токе**

**§ 4.2. Частотная и температурная зависимости электропроводности монокристаллов TlGoS^S^fy-x) в переменном токе.**

**§ 4.3. Примесная фотопроводимость монокристаллов**

**710о$2х$ег(4'х) .«**

**§ 4.4. Термостимулированные токи соединения ТЫ**

**TIGoSet, TIGaSSe . . . .-щ**

**§ 4.4.1. Термостимулированные проводимости TIGaSz**

**TlGaSe? , TIGaSSe. hi**

**§ 4.4.2. Термостимулированные деполяризации TIGqS**

**§ 4.5. Температурное гашение фотопроводимости TIGqS л TlGoSe**

**Резюме**

**ГЛАВА У. Ф0Т0В0ЛЬТАИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СИСТЕМЫ TIGQ Xz'CdSe**

**§ 5.1. Изготовление гетеропереходов /IbQX? ~ CdSe**

**§ 5.2. Спектральная характеристика фотоюльтаического эффекта в системе Ад- Wo\*- Cd&e.**

**§ 5.3. Характеристики системы Ад- ТШахг - CdSe в фотодиодном режиме.**

**Резюме.**